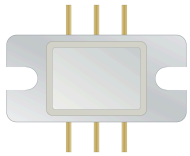
13600–14500 MHz GaN Amplificatore di potenza in contenitore — PSAT ≥ 41 dBm

LCI-PA-13600-14500-PS41MIN · 13600–14500 MHz · GaN Amplificatore di potenza in contenitore.



Valori della tabella RF: PSAT ≥ 41 dBm; Guadagno di potenza ≥ 20 dB; PAE 37 % (tipico). Condizioni di prova RF: Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; Pin = 21 dBm; CW.

CMW010B

Applicare la polarizzazione di gate prima di quella di drain. Rimuovere prima quella di drain.

Vg: C = 10 µF

Vg: 1, 3

RFin: 2

Vd: 4, 6

RFout: 5

Dimensioni del contenitore: 18.03 × 8.7 mm.

Caratteristiche RF

Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; Pin = 21 dBm; CW

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Frequenza operativa	f	13600	-	14500	MHz
Potenza di uscita satura	-	41	-	-	dBm
Guadagno di potenza	-	20	-	-	dB
Efficienza di potenza aggiunta	-	32	37	-	%
Planarità del guadagno di potenza	-	-	0.5	1	dB

Polarizzazione DC e correnti

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Valore	Unità
Tensione di drain	-	-	-	-	28	V
Tensione di gate	-	-	-	-	-3.05	V

Valori limite

Valori limite; non sono punti di lavoro normali.

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Tensione drain-source massima	-	-	-	32	V
Polarizzazione minima del gate	-	-5	-	-	V
Temperatura di stoccaggio	-	-65	-	150	°C
Potenza di ingresso massima	-	-	-	24	dBm

Dimensioni del contenitore

Parametro	Valore	Unità
Dimensioni del contenitore	18.03 × 8.7	mm
Ingombro tra i terminali	14.7	mm

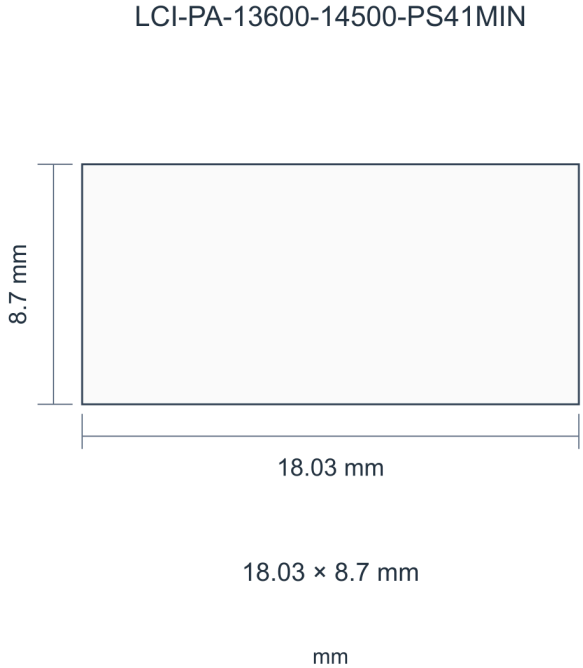
Pubblicazione corrente · 1.6 · 2026-11-12. Aggiornamento della descrizione o dei contenuti editoriali. Sostituisce la revisione 1.5.

Note di integrazione

CMW010B Applicare la polarizzazione di gate prima di quella di drain. Rimuovere prima quella di drain. Vg: C = 10 µF Vg: 1, 3 RFin: 2 Vd: 4, 6 RFout: 5

Disegno dimensionale meccanico

Disegno parziale con le dimensioni confermate in mm. Per l'installazione consultare il disegno di montaggio completo.

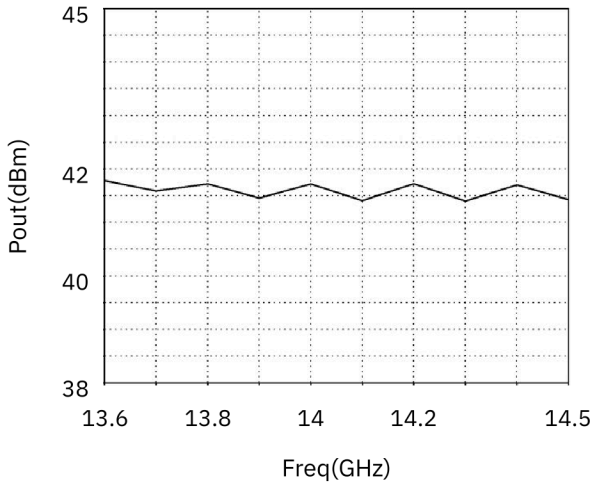


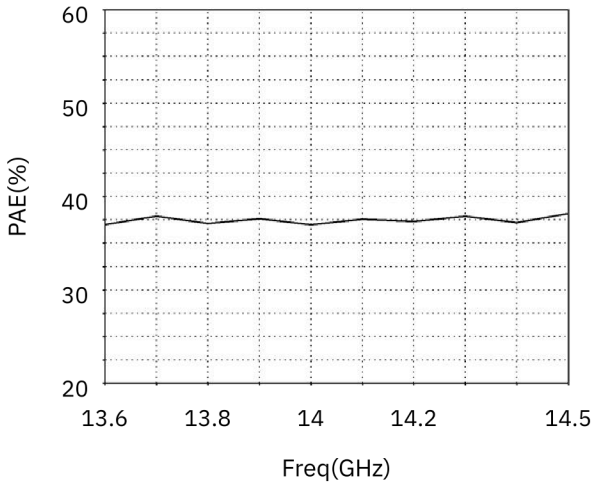
Curve di prestazione

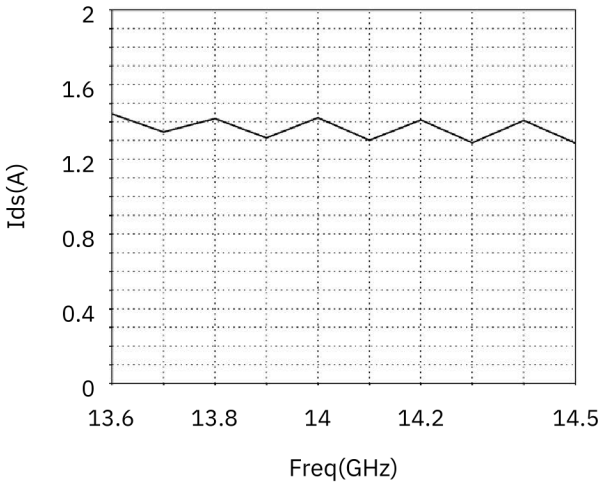
Ogni grafico delle prestazioni si riferisce alle condizioni operative indicate nella figura.

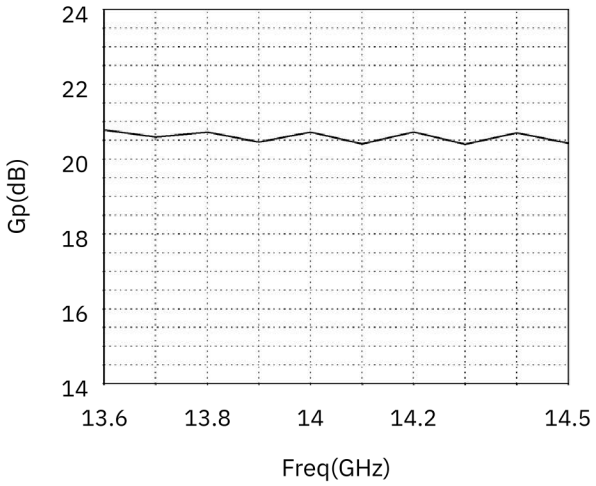
Onda continua (CW) — Potenza di uscita satura; Efficienza di potenza aggiunta; Corrente dinamica di drain; Guadagno di potenza.

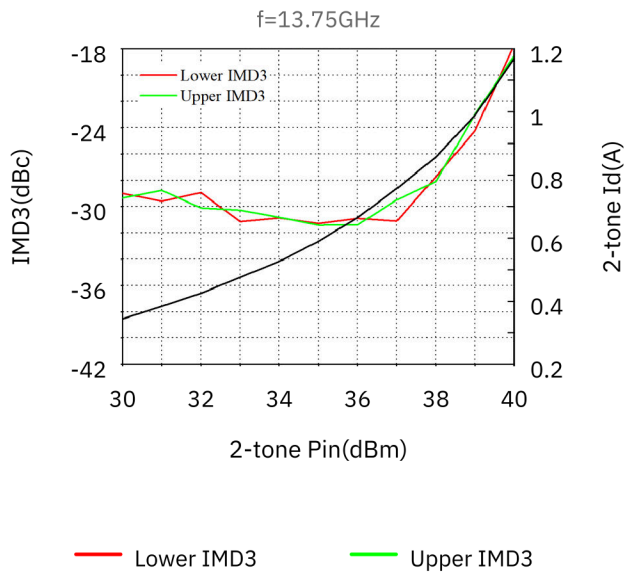
Note della figura: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-3.05V; Pin=21dBm.

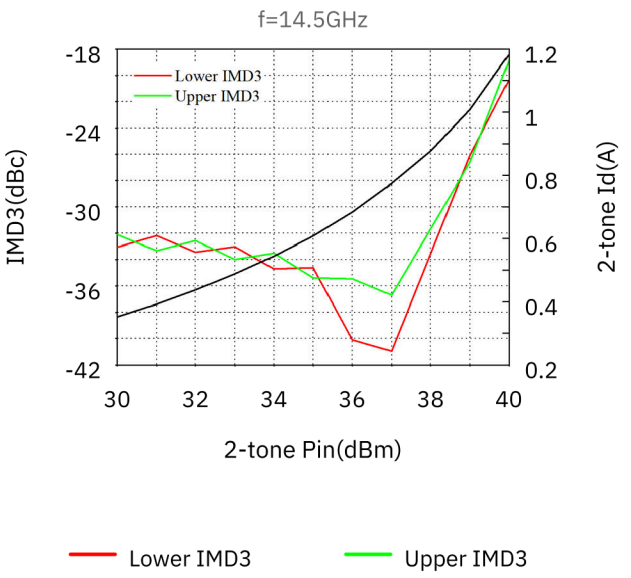


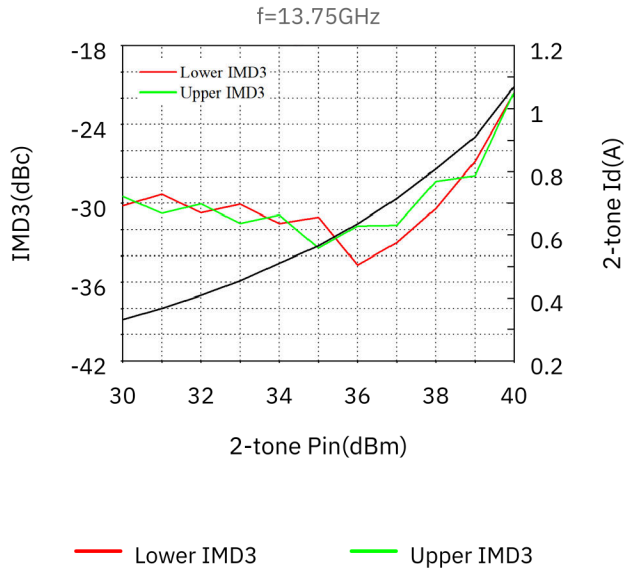


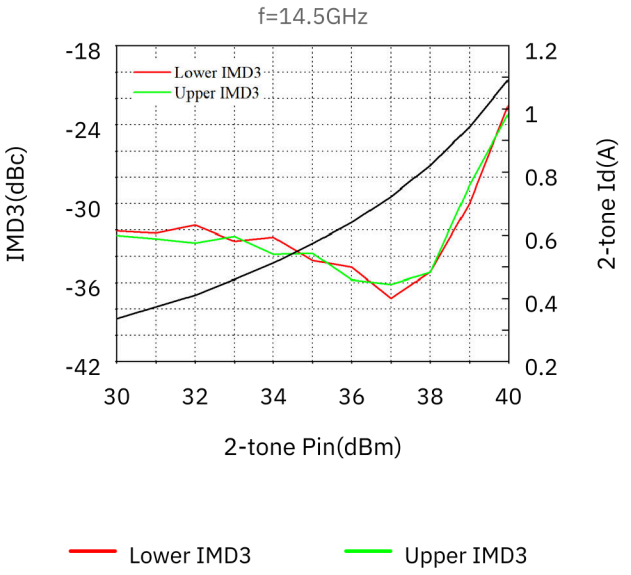












IMD3(dBc); Id(A). f = 13.75/14.5 GHz; Δf = 10 MHz; ID = 200 mA; C = 100 nF (1–2), 200 nF (3–4); Pin a due toni=30...40 dBm.

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L'offerta approvata e la documentazione d'ordine definiscono la configurazione fornita.